

SCE 307 · SCE 308 · SCE 309



Silizium-pnp-Epitaxie-Planar-Transistoren für den universellen Einsatz in der NF-Technik.

Für den Einsatz in der Hybrid- und SMD-Technik vorgesehen.

Bauform 4 SOT23

Wärmewiderstand R_{thja}

auf Leiterplatte (Cevaustit $\geq 0,4 \text{ cm}^2$) $\leq 480 \text{ K/W}$

auf Keramik $8 \times 10 \times 0,7 \text{ mm}$ $\leq 420 \text{ K/W}$

Grenzwerte

	SCE 308, 309	SCE 307
— U_{CBO}	30	50 V
— U_{CEO}	25	45 V
— U_{EBO}	5	6 V
— I_C	100	mA
— I_{CM}	200	mA
— I_B	50	mA
P_{tot} (bei $\vartheta_a \leq 25\text{ }^{\circ}\text{C}$)	300	mW
ϑ_{jmax}	150	$^{\circ}\text{C}$
ϑ_a	-55 ... +125 $^{\circ}\text{C}$	

Statische Kennwerte (bei $\vartheta_a = 25^\circ \text{C} - 5 \text{ K}$)

— I_{CBO} (bei — $U_{CB} = 30 \text{ V}$)	bei SCE 308, 309	$\leq 100 \text{ nA}$
— I_{CBO} (bei — $U_{CB} = 50 \text{ V}$)	bei SCE 307	$\leq 100 \text{ nA}$
— $U_{(BR)CEO}$ (bei — $I_C = 10 \text{ mA}$)	bei SCE 308, 309	$\geq 25 \text{ V}$
	bei SCE 307	$\geq 45 \text{ V}$

h_{21E} (— $U_{CE} = 6 \text{ V}$, — $I_C = 2 \text{ mA}$)	Gruppe c	56 ... 140
	Gruppe d	112 ... 280
	Gruppe e	224 ... 560

Dynamische Kennwerte (bei $\vartheta_a = 25^\circ \text{C} - 5 \text{ K}$)

f_T (— $U_{CE} = 6 \text{ V}$, — $I_C = 10 \text{ mA}$, $f = 20 \text{ MHz}$)	Gruppe c typ	145 MHz
	Gruppe d typ	254 MHz
	Gruppe e typ	295 MHz

F (— $U_{CE} = 6 \text{ V}$, — $I_C = 0,2 \text{ mA}$, $f = 1 \text{ KHz}$,	SCE 307/308	$\leq 8 \text{ dB}$
---	-------------	---------------------

$\Delta f = 200 \text{ Hz}$, $R_G = 2 \text{ KOhm}$)

F (— $U_{CE} = 6 \text{ V}$, — $I_C = 0,2 \text{ mA}$, $f = (0,03 \dots 15) \text{ KHz}$, $R_G = 2 \text{ KOhm}$)	SCE 309	$\leq 4 \text{ dB}$
---	---------	---------------------

Kleinleistungstransistoren für allgemeine und NF-Anwendungen

Typ	Struktur	Grenzwerte ($T_a = 25^\circ\text{C}$)				Kennwerte											Bauform
		P_{tot} (mW)	U_{CBO} (V)	U_{CEO} (V)	I_{C} (mA)	$h_{21\text{E}}$ bei I_{C}	I_{C} (mA)	U_{CE} (V)	f_{T} bei I_{C} (MHz)	I_{C} (mA)	U_{CEsat} bei I_{C} (mV)	I_{C} (mA)	F bei U_{CE} (dB)	U_{CE} (V)	I_{C} (mA)	f (kHz) (MHz)*	
SCE 307*	pn-p	150	50	45	100	56...560	2	6	> 100	10	85 340	10 100	8	6	0,2	1	78
SCE 308*	pn-p	150	30	25	100	56...560	2	6	> 100	10	85 340	10 100	8	6	0,2	1	78
SCE 309*	pn-p	150	30	25	100	56...560	2	6	> 100	10	85 340	10 100	4	6	0,2	0,03...15	78
SCE 535*	np-n		75	45	1000	40...250	150	2	50	50	500	500					79
SCE 537*	np-n		60	60	1000	40...250	150	2	50	50	500	500					79
SCE 539*	np-n		100	80	100	40...250	150	2	50	50	500	500					79
SCE 536*	pn-p		45	45	100	40...250	150	2	50	50	500	500					79
SCE 538*	pn-p		60	60	1000	40...250	150	2	50	50	500	500					79
SCE 540*	pn-p		100	80	1000	40...250	150	2	50	50	500	500					79

* selektiert nach der Stromverstärkung

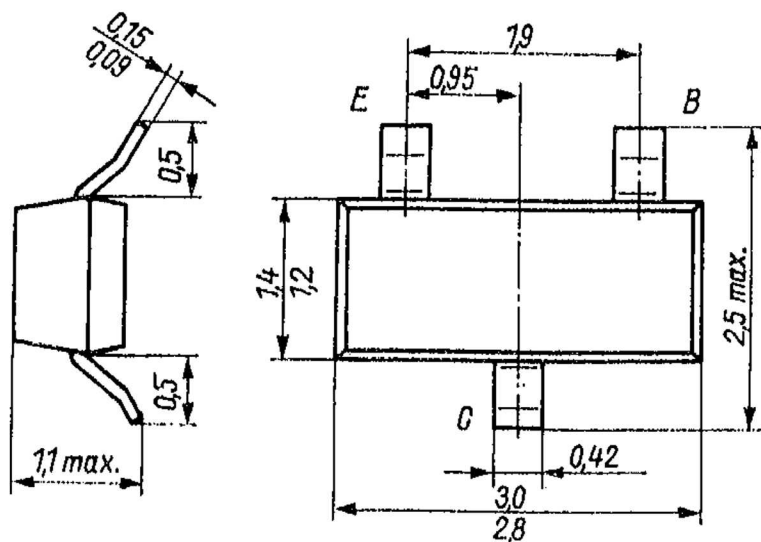


Bild 78

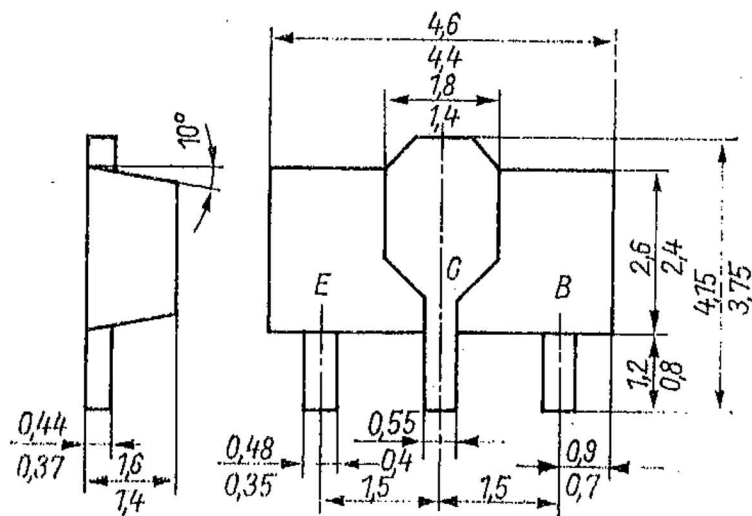


Bild 79